

Транзисторная сборка 1НТ251

состоит из четырех кремниевых n-p-n переключаемых транзисторов эпитаксиально-планарной структуры. Предназначена для применения в переключающих устройствах. Выпускается в металлокерамических корпусах с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе.

Масса сборки не более 0,4 г.

Корпус: 401.14-6

Основные технические характеристики:

Структура транзистора:	n-p-n
Постоянная рассеиваемая мощность	400 мВт
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее	200 МГц
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора	45 В (1кОм)
Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора	4 В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора:	400 мА
Максимально допустимый импульсный ток коллектора	800 мА
Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более	6 мА (45В)
Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: более;	5
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более	1000 Ом